



汕头华汕电子器件有限公司

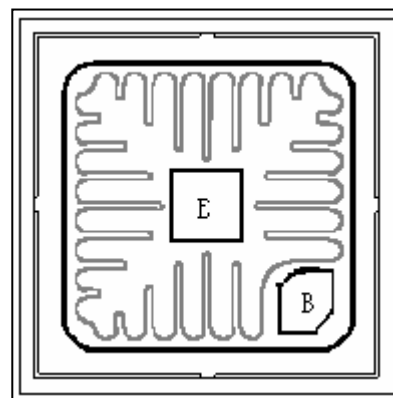
NPN SILICON TRANSISTOR

882 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C105AJ-00
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：1050×1050μm²
焊位尺寸：B 极 230×230μm²；E 极 170×170μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2SD882，HS882，H882

芯片图



极限值 (T_a=25°C) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg}——贮存温度……………-55~150°C
T_j——结温……………150°C
P_C——集电极功率耗散 (T_c=25°C) ……………10W
P_C——集电极功率耗散 (T_A=25°C) ……………1W
V_{CBO}——集电极—基极电压……………40V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……………30V
V_{EBO}——发射极—基极电压 ……………5V
I_C——集电极电流 ……………3A
I_B——基极电流……………0.6A

电参数 (T_a=25°C) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流	60	0.3	1	μA	V _{CB} =30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	μA	V _{EB} =5V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益			400		V _{CE} =2V, I _C =1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降		0.3	0.5	V	I _C =2A, I _B =0.2A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降		1.0	2	V	I _C =2A, I _B =0.2A
C _{ob}	输出电容		45		pF	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz
f _T	特征频率		90		MHz	V _{CE} =5V, I _E =0.1A